

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☐; Giảng viên thỉnh giảng ☒

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Trần Thuật

2. Ngày tháng năm sinh: 16/09/1980; Nam ☒; Nữ ☐; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☐

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Thăng Lợi, Thường Tín, Hà Nội

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Số 20B, ngách 144/8, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): P1405, tòa nhà Golden Palace, 54 Lê Văn

Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0985516980;

E-mail: thuatnt@vnu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 2009 đến năm 2011: Nghiên cứu viên, phó Trưởng bộ phận sau đó Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển tại Phòng Thí Nghiệm Công nghệ Nano

Từ năm 2012 đến năm 2013: Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nano và Năng lượng

Từ năm 2014 đến năm 2020: Nghiên cứu viên, sau đó Nghiên cứu viên chính tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Chức vụ: Hiện nay: Nghiên cứu viên chính; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 02435406136

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Việt Nhật

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Việt Nhật

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 17 tháng 03 năm 2005, ngành: Kỹ sư đa ngành, chuyên ngành: Bán dẫn và Ứng dụng
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Bách khoa Paris, Pháp

- Được cấp bằng ThS ngày 17 tháng 03 năm 2005, ngành: Vật lý Ứng dụng, chuyên ngành: Điện tử và Quang điện tử

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Bách khoa Paris, Pháp

- Được cấp bằng TS ngày 20 tháng 05 năm 2009, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Bách khoa Paris, Pháp

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Năng lượng mặt trời, cụ thể là ứng dụng năng lượng mặt trời nói chung và quang năng nói riêng cho việc chiếu sáng trong nhà vào ban ngày.
- Vật liệu hợp chất bán dẫn oxit, cụ thể là loại hợp chất delafossite ABO_2 , ứng dụng trong pin mặt trời loại màng mỏng với chi phí thấp và trong cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt,
- Vật liệu perovskite kim loại hữu cơ halogen, cụ thể là ứng dụng trong pin mặt trời và các linh kiện quang điện tử, lượng tử tiên tiến.
- Vật liệu cấu trúc lõi polymer vỏ kim loại quý, cụ thể là ứng dụng trong màng dẫn điện bất đẳng hướng.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 7 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);
- Đã hoàn thành 2 đề tài NCKH cấp Nhà nước; 2 đề tài NCKH cấp Bộ;
- Đã công bố (số lượng) 55 bài báo KH, trong đó 27 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 2 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng 0 tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
Không có			

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

- Thâm niên giảng dạy: 6 năm đủ giờ chuẩn giảng dạy.

- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia, 01 đề tài cấp nhà nước, 01 đề tài nghiên cứu cơ bản Quỹ Nghiên cứu khoa học Quốc gia (Nafosted).

- Hướng dẫn thạc sĩ: 07 thạc sĩ đã được nhận bằng/quyết định công nhận học vị thạc sĩ.

- Hướng dẫn NCS: 01 với vai trò hướng dẫn phụ.

- Công trình công bố: 57 công trình trong đó 27 công trình khoa học công bố tại các tạp chí khoa học uy tín, 2 bằng sáng chế, và các công trình khoa học khác.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên *:

- Tổng số 6 năm.

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/Số giờ quy đổi/Số giờ định mức
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2014 - 2015				2	80	40	120/58/135

2	2015 - 2016			1	4	240	40	280/156/135
3	2016 - 2017			1	2	80	40	120/82/135
3 năm học cuối								
4	2017 - 2018			1	2	160	86	236/113/135
5	2018 - 2019			1	1	278		278/33/135
6	2019 - 2020			1		120		120/23/135

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh, Pháp

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☒:

- Học ĐH ☒; Tại nước: Pháp; Từ năm 2001 đến năm 2003

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☒ hoặc TSKH ☐; Tại nước: Pháp năm 2008

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☒:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, học viên CH, BSCK, BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			

1	Nguyễn Đình Nghĩa		X	X		06/2011 đến 12/2012	Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội	07/05/2013
2	Trần Đặng Bảo Ân		X	X		01/2013 đến 06/2013	Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh	20/07/2013
3	Nguyễn Minh Tú		X		X	04/2015 đến 01/2016	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội	28/03/2016

4	Đỗ Ngọc Hiệu		X	X		11/2015 đến 07/2017	Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội	28/06/2017
5	Trần Ngọc Lâm		X	X		12/2017 đến 07/2018	Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội	7/01/2018
6	Phan Vũ Thị Vân		X	X		07/2017 đến 12/2018	Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội	27/12/2018

7	Lý Văn Nam		X		X	05/2018 đến 08/2019	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội	26/8/2019
---	------------	--	---	--	---	---------------------------	--	-----------

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Không có							

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 0

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	ĐT: Chế tạo thẻ nhận dạng sử dụng ăng-ten sóng radio bằng công nghệ nano	CN	07/2009/HĐ-ĐTĐL, cấp Nhà nước	01/06/2009 đến 30/6/2011	21/8/2012; Khá
2	ĐT: Nghiên cứu chế tạo vật liệu perovskite vô cơ – hữu cơ ứng dụng cho lớp hấp thụ của pin mặt trời tiếp giáp dị thể	CN	103.02-2014.81, cấp Nhà nước	01/03/2015 đến 01/03/2018	27/6/2018, Đạt
3	ĐT: Chế tạo ăng-ten cho thẻ nhận dạng bằng sóng Radio	CN	B2009-32-01, cấp Bộ	01/01/2009 đến 31/12/2009	25/11/2010, Đạt
4	ĐT: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng dạng delafossite CuFeO ₂	CN	QG.14.24, cấp Bộ	01/04/2014 đến 01/04/2016	4/8/2016, Tốt

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Strong orange/red electroluminescence from hydrogenated polymorphous silicon carbon light-emitting device	6	Không	Applied Physics Letters	Q1 - SCI IF: 3.597	19	92 , 241114	2008
2	Optimization of electroluminescent diodes based on pm-SiC:H deposited at low temperature	5	Không	Materials Science and Engineering B	Q1 - SCI IF: 4.706	3	B147 , 245	2008
3	Low temperature plasma synthesis of silicon nanocrystals: a strategy for high deposition rate and efficient polymorphous and microcrystalline solar cells	6	Không	Plasma Physics and Controlled Fusion	Q1 - SCI IF: 2.829	27	50 , 124037	2008

4	Synthesis of silicon nanocrystals in silane plasmas for nanoelectronics and large area electronic devices	6	Không	Journal of Physics D: Applied Physics	Q1 - SCI IF: 3.169	70	40 , 2258	2007
5	Study of radial growth rate and size control of silicon nanocrystals in square-wave modulated silane plasmas	3	Có	Applied Physics Letters	Q1 - SCI IF: 3.597	18	91 , 111501	2007
6	Fluctuation microscopy evidence for enhanced nanoscale structural order in polymorphous silicon thin films	6	Có	Journal of Applied Physics	Q2 - SCI IF: 2.286	17	100 , 94319	2006
7	Optical study of disorder and defects in hydrogenated amorphous silicon carbon alloys	3	Có	Applied Physics Letters	Q1 - SCI IF: 3.597		87 , 11903	2005
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
8	Simulation of coupling optical modes in 1D photonic crystals for optoelectronic applications	2	Có	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	Q1 - SCIE IF: 3.783		5 , 142	2020

9	Growth and morphology control of CH ₃ NH ₃ PbBr ₃ crystals	8	Có	Journal of Materials Science	Q1 - SCI IF: 3.553		54 , 14797	2019
10	Detection analysis limit of nonlinear characteristics of DNA sensors with the surface modified by polypyrrole nanowires and gold nanoparticles	6	Không	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	Q1 - SCIE IF: 3.783	1	3 , 129	2018
11	Optical and electrical responses of magnetron-sputtered amorphous Nb-doped TiO ₂ thin films annealed at low temperature	9	Không	Physica B: Condensed Matter	Q2 - SCI IF: 1.902	4	532 , 200	2018
12	Synthesis of organotin halide perovskites via simple aqueous acidic solution-based method	5	Có	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	Q1 - SCIE IF: 3.783	5	3 , 471	2018
13	Selected-area growth of nickel micropillars on aluminum thin films by electroless plating for applications in microbolometers	6	Có	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	Q1 - SCIE IF: 3.783	1	2 , 192	2017

14	Synthesis of tantalum-doped tin oxide thin films by magnetron sputtering for photovoltaic applications	9	Có	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.774	15	46 , 3622	2017
15	Three-photon absorption induced photoluminescence in organo-lead mixed halide perovskites	13	Có	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.774	3	46 , 3667	2017
16	Fabrication of copper(I) bipyridyl complex based dye sensitized solar cells	7	Có	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.774	2	46 , 3639	2017
17	Thermoelectric micro-refrigerator based on bismuth/antimony telluride	7	Không	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.774	2	46 , 3660	2017
18	Stimulated absorption of light in bosonic cascades of excitons	5	Không	Superlattices and Microstructures	Q2 - SCI IF: 2.12	3	109 , 454	2017
19	Optical and structural study of organometal halide materials for applications in perovskite-based solar cells	9	Có	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.774	10	45 , 2322	2016

20	Optical study of cuprous oxide and ferric oxide based materials for applications in low cost solar cells,	9	Có	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.774	2	45 , 2407	2016
21	Optimization of synthesis of ZnO:Al as n-type transparent conductive layer for oxide-semiconductor-based solar cells	10	Có	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.774	4	45 , 2442	2016
22	Fabrication of PDMS-based microfluidic devices: application for synthesis of magnetic nanoparticles	8	Không	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.774	7	45 , 2576	2016
23	Doped semiconductor nanocrystal junctions	4	Không	Journal of Applied Physics	Q2 - SCI IF: 2.286	10	144 , 204305	2013
24	Effect of temperature in electrochemical texturizing of multicrystalline silicon in KOH solution	5	Không	International Journal of Nanotechnology	Q4 - ESCI IF: 0.532		10 , 288	2013

25	Development and application investigation of an ICSHG 532 nm diode-pumped solid-state laser system	5	Không	Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology	Q1 - ESCI		2 , 45008	2011
26	A new platform for RFID research in Vietnam	6	Không	Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology	Q1 - ESCI	10	1 , 45015	2010
27	Mapping charge transfers between quantum levels using noncontact atomic force microscopy	8	Không	Physical Review B	Q1 - SCI IF: 3.575	12	82 , 73302	2010
28	Growth of single crystals of methylammonium lead mixed halide perovskites	5	Có	Communications in Physics			28 , 237	2018
29	Electrical properties of Nb-doped TiO ₂ thin films deposited by co-sputtering process	5	Không	VNU Journal of Science: Mathematics - Physics			33 , 44	2017
30	Fabrication of organolead iodide perovskite solar cells with niobium-doped titanium dioxide as compact layer	10	Có	Communications in Physics			27 , 121	2017

31	Characterization of ZnO:Al deposited by co-sputtering for transparent conductive electrodes	8	Có	Communications in Physics			25 , 341	2015
32	Study on the deposition of amorphous silicon and ITO thin films for heterojunction solar cell application	7	Không	Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh			16 , 101	2013
33	Improvement of short circuit current of mono crystalline silicon solar cells	6	Không	Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh			16 , 48	2013
34	Synthesis of two-dimensional hybrid organic inorganic perovskite materials for applications in solar cells and optoelectronics	8	Có	Vietnam – Japan Science and Technology Symposium – Towards Sustainable Development Proceedings			, 106	2019
35	Synthesis of poly(methyl methacrylate) conductive core shell microspheres by polymerization and electroless plating of silver	5	Có	Vietnam – Japan Science and Technology Symposium – Towards Sustainable Development Proceedings			, 110	2019

36	Fabrication of a thermoelectric cooler based on bismuth/antimony telluride	9	Không	Proceeding of The 6th International workshop on Nanotechnology and Application 2017			, 247	2017
37	Developing innovative solar energy products in vietnam: An example of issues and solutions	2	Có	International Conference on Financing For Innovation, Entrepreneurship and Renewable Energy Development			, 30	2017
38	Synthesis of silicon nanocrystals by cold plasma for application in optoelectronics and nanoelectronics	2	Không	Plasma Application and Hybrid Functionally Materials			26 , 31	2017
39	Fabrication of optical band-pass filter by electron-beam ion assisted deposition evaporation technique	4	Không	Proceedings of the third international conference on advanced materials and nanotechnology, ICAMN2016			, 178	2016

40	Optimization for analytical model of rear side point contact UMG-Si solar cells	5	Không	Proceeding of The 4th International workshop on Nanotechnology and Application 2013, IWNA2013			, 163	2013
41	Improving radiation characteristics of UHF RFID antennas by zigzag structures	8	Có	Proceedings of The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC-2011)		7	, 102	2011
42	Design and fabrication of UHF RFID tag	7	Có	Proceedings of The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC-2011)		1	, 98	2011
43	Contribution on UHF RFID antenna design and tag fabrication	9	Có	Proceedings of the IEEE International Conference on RFID – Technologies and Applications (RFID-TA)		1	, 463	2011

44	Deposition of hydrogenated amorphous and microcrystalline silicon by pecvd for thin film and heterojunction solar cells	5	Không	Proceeding of The 3th International workshop on Nanotechnology and Application 2011, IWNA2011			, 945	2011
45	Planar antennas for UHF RFID passive tags	7	Không	Proceedings of The 2011 International Symposium on Electrical-Electronics Engineering ISEE2011			, 18	2011
46	RFID UHF tag processing for demonstration purpose	5	Không	Proceeding of The 2th International workshop on Nanotechnology and Application 2009			, 588	2009
47	Study of RFID antenna fabrication	6	Không	Proceeding of The 2th International workshop on Nanotechnology and Application 2009, IWNA2009			, 584	2011

48	Chế tạo bề mặt siêu ky nước bằng phương pháp tạo vi cấu trúc phân tầng ứng dụng trong kênh dẫn sáng	5	Không	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017			, 727	2017
49	Thiết kế và chế tạo hệ thấu hệ kính rắn ứng dụng trong thu nhận ánh sáng mặt trời	5	Không	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017			, 731	2017
50	Tổng hợp và điều khiển hình thái bề ngoài đơn tinh thể lai cơ kim halogen perovskite cho ứng dụng quang điện tử	11	Không	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017			, 556	2017
51	Tổng hợp và ăn mòn màng mỏng SiNx ứng dụng trong chế tạo các linh kiện vi cơ điện tử	4	Có	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017			, 548	2017
52	Thiết kế mô phỏng hộp hấp thụ thành đa lớp ứng dụng trong cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt	6	Có	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017			, 580	2017

53	Chế tạo vật liệu hợp chất oxit kim loại có hệ số nhiệt điện trở cao bằng phương pháp phún xạ	7	Có	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017			, 544	2017
54	Chế tạo và mô phỏng cần chuyển đổi năng lượng dựa trên vật liệu áp điện không chì AIN	8	Không	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017			, 257	2017
55	Tối ưu hóa và chế tạo điện cực điểm mặt sau của pin năng lượng mặt trời dựa trên đế UMG-Si	3	Không	Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng lần III			, 456	2013

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 10

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS. 7.2. Bảng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Phương pháp và thiết bị thu nhận ánh sáng mặt trời	Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, Việt Nam	08/10/2018	Nguyễn Trần Thuật	4
2	Thấu kính hội tụ kết nối với sợi quang và thiết bị thu nhận ánh sáng mặt trời sử dụng thấu kính này	Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, Việt Nam	26/05/2020	Nguyễn Trần Thuật	5

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS

hoặc được cấp bằng TS: 1 2

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
Không có				

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Cấp quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ	Vai trò	Cơ sở giáo dục đại học
1	Chương trình đào tạo: Vật lý kỹ thuật và Điện tử (Engineering Physics and Electronics)	Chủ trì	Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UỶ CHỨC DANH GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UỶ CHỨC DANH PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)